

## Caracterización electrónica de junturas semiconductoras basadas en nanohilos de InAs

- Joan J. Cáceres,<sup>1</sup> Leandro Tosi<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>*Instituto Balseiro - Universidad Nacional de Cuyo*

<sup>2</sup>*Grupo de Dispositivos y Sensores, CAB-CNEA y CONICET.*

En el presente trabajo presentamos mediciones de caracterización electrónica de junturas semiconductoras basadas en nanohilos de InAs que funcionan como FETs (field-effect transistors). Los nanohilos presentan pocos canales de conducción, y las propiedades varían con la tensión de compuerta aplicada entre un comportamiento más metálico a un comportamiento más aislante. Para la fabricación de las muestras se utilizaron técnicas de litografía que describimos en detalle.